

## КТ616А, КТ616Б

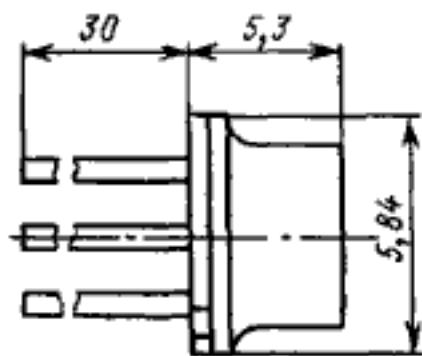
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* переключательные.

Предназначены для работы в переключающих схемах.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,6 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_Э = 0,5$ А не менее:	
КТ616А . . . . .	40
КТ616Б . . . . .	25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ А не более . . . . .	
	0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ А не более . . . . .	
	2 В
Время рассасывания при $I_К = 0,15$ А, $I_Б = 0,015$ А не более:	
КТ616А . . . . .	50 нс
КТ616Б . . . . .	15 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В не более . . . . .	
	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ0} = 0$ не более . . . . .	
	50 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ0} = 10$ В не более . . . . .	
	15 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 20$ В, $R_{ЭБ} = 10$ кОм не более . . . . .	
	15 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 4$ В не более . . . . .	
	15 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} = 10 \text{ кОм}$ . . . . .	20 В
Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .	20 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	4 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	400 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{н} = 80 \text{ нс}$ , $Q \geq 10$ . . . . .	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 233 \div 298 \text{ К}$ . . . . .	0,3 Вт
при $T = 358 \text{ К}$ . . . . .	0,25 Вт
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда . . . . .	260 К/Вт
Температура перехода . . . . .	423 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358 К

Примечание. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до температуры не более 533 К, в течение не более 10 с. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–3 мм. Запрещается кручение вывода вокруг оси.